

Chave óptica interruptiva infravermelha Sem abas de fixação – C860NP

Destaques:

- Alta sensibilidade e alto ganho;
- Tecnologia AlGaAs/GaAs – fototransistor Si;
- Excelente performance e veloc. chaveamento;
- Adequado para montagem através de furos - PTH;
- Suporta fixação por processo solda à onda;
- Não contém produtos nocivos ao meio ambiente.
- Atende à normativa RoHS.

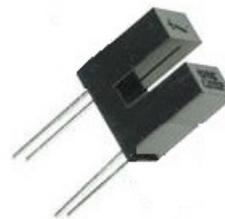


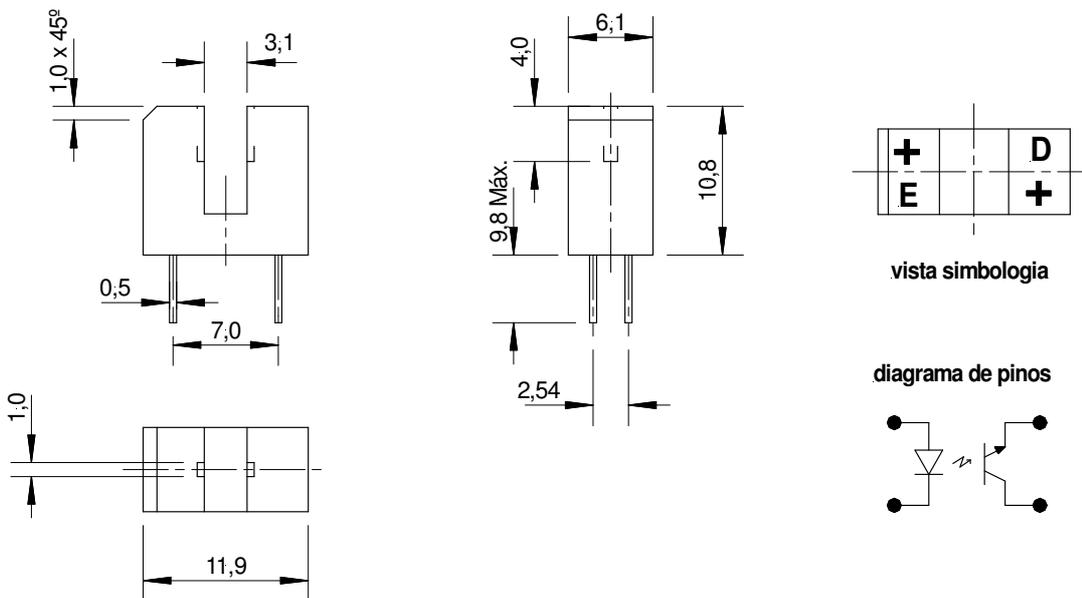
Imagem ilustrativa

Aplicações típicas:

- Detectores de posição/fim de curso;
- Detectores de presença;
- Detector de fumaça;
- Sistema de segurança infravermelho;
- Outros periféricos.

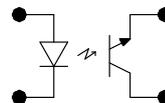
Dispositivo que consiste de um diodo emissor infravermelho frontalmente posicionado contra um fototransistor (NPN) de silício, espectralmente compatíveis, encapsulados em um suporte de termoplástico resistente à temperatura.

Dimensões Físicas



vista simbologia

diagrama de pinos



- Todas as dimensões em milímetros.
- Tolerâncias não especificadas: $\pm 0,20\text{mm}$.

Características Gerais

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Código Fabrica | Código Produto | Encapsulamento | Tecnologia do chip |
| 710.002 | C860NP | Termoplástico | AlGaAs/GaAs - Si |

Características Máximas Absolutas - T_{AMB}: 25 °C

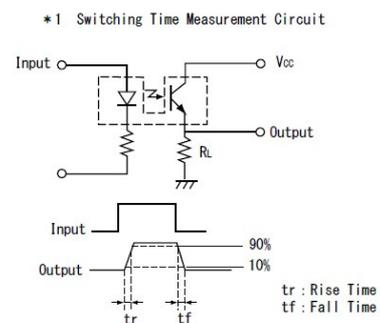
| | | Símbolo | Valor | Unidade |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|
| Emissor | Potência dissipada | Pd | 100 | mW |
| | Tensão reversa | Vr | 5 | V |
| | Corrente Direta | If | 60 | mA |
| | Corrente direta de pico (100us:10ms) | Ifp | 250 | mA |
| Sensor | Potência dissipada coletor-emissor | Pc | 100 | mW |
| | Corrente de coletor | Ic | 60 | mA |
| | Tensão C-E | Vceo | 30 | V |
| | Tensão E-C | Veco | 6,0 | V |
| Temperatura de operação | | Topr | -20 a +75 | °C |
| Temperatura de armazenagem | | Tstg | -25 a +85 | °C |
| Temperatura de solda (t < 3s) | | Tsld | 260 | °C |

Características de Operação - T_{AMB}: 25 °C

| Parâmetro | | símbolo | condição | Min | Típ | Max | Unid. |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| Emissor | Tensão direta | Vf | If= 50mA | - | 1,3 | 1,6 | V |
| | Corrente reversa | Ir | Vr= 5V | - | - | 10 | uA |
| | Comprimento de onda - efetivo | | | - | 940 | - | nm |
| Sensor | Corrente de "escuro" | Id | Vce= 10V | - | - | 0,1 | uA |
| | Pico de sensibilidade | | | 930 | | 950 | nm |
| | Tensão de saturação C-E | Vce(sat) | Ic= 0,5mA If= 20mA | - | - | 0,4 | V |
| Corrente de "claro" | | IL | Vce= 5V If= 20mA | 0,3 | - | - | mA |
| CTR | | | Vce= 5V If= 20mA | 20 | - | - | % |
| Tempo de resposta | | T _R - T _F | If= 20mA Vcc= 5V RI= 1 KOhm | - | 20 | - | µs |

Nota importante:

Os níveis de ganho das chaves, da forma que são entregues, atendem à maioria das aplicações. Entretanto para aplicações mais críticas onde é necessário maior uniformidade entre os componentes, é sugerido contatar nosso departamento comercial para solicitação da classificação das chaves.



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo de fornecimento | À granel |
| Tipo de Embalagem | Saco polietileno (comum) |
| Quantidade padrão por embalagem | 200 unidades |

Nota: características suscetíveis à mudança sem aviso prévio.

| | | | |
|----------------|------------|----------|----------------|
| Preparado por: | Data: | Revisão: | Aprovado: |
| Bruna Bezerra | 25/11/2015 | 01 | Milton Shimomi |